

国際調査報告

国際出願番号 PCT/JP03/09548

A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl⁷ C01B31/02

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl⁷ C01B31/02

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報	1922-1996年
日本国公開実用新案公報	1971-2003年
日本国登録実用新案公報	1994-2003年
日本国実用新案登録公報	1996-2003年

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

WEB OF SCIENCE, JOIS [nanotube, CVD, transistor]

C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
X	木下誠三, 外4名, 位置制御成長カーボンナノチューブによる室温 クーロンブロッケイド, 電子情報通信学会技術研究報告, 2002.01.29, Vol.101, No.618, p.47-52	1-4, 9, 10, 12-16, 20-22, 25-29, 31, 34
Y		11, 23, 24, 32, 33
A		5-8, 17-19, 30
Y	S. J. WIND, et al, Vertical scaling of carbon nanotube field- effect transistors using top gate electrodes, APPL. PHYS. LETT., 2002.05.20, Vol.80, No.20, p.3817-3819	11

☒ C欄の続きにも文献が列挙されている。☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

「A」 特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの
「E」 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの
「L」 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す)
「O」 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
「P」 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

「T」 国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの
「X」 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
「Y」 特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの
「&」 同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

29.10.03

国際調査報告の発送日 18.11.03

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/JP)

郵便番号 100-8915

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官 (権限のある職員)

板谷 一弘



4G

3028

電話番号 03-3581-1101 内線 3416

C-(続き) 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
Y	JP 11-011917 A (キヤノン株式会社) 1999.01.19, [0060], [0061], [0065]段落, (ファミリーなし)	23, 32
Y	EP 1129990 A1 (LUCENT TECHNOLOGIES INC.) 2001.09.05, [0016]段落, EXAMPLE 1, & JP 2001-262343 A, [0026]段落, 実施例 1, & CA 2331278 A, & AU 2308501 A	23, 32
Y	JP 08-100328 A (キヤノン株式会社) 1996.04.16, 特許請求の範囲, (ファミリーなし)	24, 33
Y	EP 1061043 A1 (IIJIN NANOTECH CO., LTD) 2000.06.15, CLAIM 3, & JP 2001-020072 A, 請求項 3, & KR 2001-066816 A, & CN 1277147 A	24, 33

(03USFP883)

Translation of ISR

BOX C

Category	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	Room Temperature Coulomb Blockade Characteristics of Position Controlled Grown Carbon Nanotube Seizo KINOSHITA et al. 2002.01.29, Vol.101, No.618, p.47-52	1-4, 9,10,12-16,20-22,25-29,31,34,11,23,24,32,33 5-8,17-19,30
Y		
A		
Y	S.J.WIND, et al, Vertical scaling of carbon nanotube field-effect transistors using top gate electrodes, APPL.PHYS.LETT., 2002.05.20, Vol.80, No.20, p3817-3819	11
Y	JP 11-011917 A (Canon Inc.) 1999.01.19 [0060] [0061] [0065] (Family:none)	23,32
Y	EP 1129990 A1 (LUCENT TECHNOLOGIES INC.) 2001.09.05 [0016] ESAMPLE 1 & JP2001-262343A [0026] EMBODIMENT 1 & CA 2331278 A, & AU 2308501 A	23,32
Y	JP 08-100328 A (Canon Inc.) 1996.04.16 ALL CLAIMS (Family:none)	24,33
Y	EP 1061043 A1 (IIJIN NANOTECH CO., LTD) 2000.06.15 CLAIM 3, & JP2001-020072A CLAIM3 & KR2001-066816A & CN1277147A	24,33